文章编号: 1007-4627(2015)03-0310-08

分子镀制备三种镧系元素靶

张鑫^{1,2},吴晓蕾¹,曹石巍^{1,2},王洋^{1,2,3},秦芝¹

(1. 中国科学院近代物理研究所,兰州 730000;
2. 中国科学院大学,北京 100049;
3. 兰州大学,兰州 730000)

摘要: 采用分子镀方法研究了异丙醇-硝酸体系中两极间距离、电流密度、加入HNO₃的量和分子镀持续 时间对镀层性能和电沉积效率的影响,确定了制备 Tb, Dy和 Ho 靶的最佳工艺条件。同时也探索了在异 丁醇-硝酸体系中,分子镀持续时间和电流密度对 Tb 靶电沉积效率的影响。因 Tb, Dy和 Ho 三种元素化 学性质相近,故采用了相同的工艺条件: 两极间最优距离为 15 mm,电流密度为 5.7 mA/cm²,加入 0.1 mol/L HNO₃ 400 μL,分子镀时间为 1 h。用分光光度法测得各靶的沉积效率均高于85%;利用扫描电子显 微镜(SEM)对部分靶的表面形貌分析后发现靶面结构均匀致密;利用能谱仪(EDS)对靶子进行了定性和半定 量分析;利用红外光谱法对靶膜化学成分进行了分析,发现靶膜成分结构复杂,不是由一种化合物组成。目 前制得的 Tb 靶和 Ho 靶已用于中国科学院近代物理研究所加速器 SFC 低能核化学终端上,利用¹⁹F 束流轰 击,分别产生了 W和 Os 的短寿命同位素,从而成功完成了 Sg(Z = 106)和 Hs(Z = 108)的模型试验。 关键词:分子镀;镧系元素靶;沉积效率

中图分类号: X125 文献标志码: A DOI: 10.11804/NuclPhysRev.32.03.310

1 引言

通常把104号元素及以后的元素称为超重元素^[1], 对超重元素化学性质的研究主要是探讨相对论效应 对超重元素核外电子排布情况的影响。近年来,核 化学家在超重元素化学性质的实验研究方面取得了 突破性的进展^[2],已经在气相及液相方面对104(Rf), 105(Db), 106(Sg)的化学性质进行了一些研究,而对 于107(Bh),108(Hs),112号元素只进行了气相色谱实 验的研究,并确定了它们在元素周期表中的位置,分 别位于同族较轻元素Hf, Ta, W, Re, Os, Hg的下 面。为了研究超重元素 Sg(Z = 103), Bh(Z = 107)以 及Hs(Z = 108)的气相化学性质,可以利用¹⁹F离子轰 击稀土元素 Tb(Z = 65), Dy(Z = 66) 以及 Ho(Z = 67) 靶产生分别属于第6.7.8族的短寿命W, Re和Os的 同位素,进行Sg,Bh和Hs的化学性质研究的模拟实 验。因此制备出均匀、牢固且厚度为1.0 mg/cm² 左右 的 Tb, Dy 和 Ho 靶对我们的实验是十分重要的。

目前,国内外一些研究者大多采用分子镀方法制 备稀土元素靶^[3-6],该技术适于多种元素的电镀,所 用设备简单,易于操作,且沉积效率高,所需时间短, 靶与底衬之间有较好的吸附力^[4-5]。在超重核的研究 中,人们通常选薄的Al箔(厚度从2到13 μm不等)、 Be(20 μm)箔或者Ti箔(最薄为1 μm)为靶衬,在异丙 醇硝酸体系中,采用所镀金属的硝酸盐为主盐,把金属 沉积在相应的靶衬上,从而制成符合实验要求的核素 靶^[3-5,7]。本文对异丙醇-硝酸体系中,单次分子镀法制 备Tb,Dy和Ho靶的工艺流程、实验最佳条件和实验 结果进行研究,而且对异丁醇-硝酸体系中的分子镀制 靶条件进行一定程度的探索。

2 实验材料和方法

2.1 主要试剂

氧化铽 (Tb₄O₇) (天津市津科精细化工研究所)、氧 化镝 (Dy₂O₃) (中国上海)、氧化钬 (Ho₂O₃)(天津市丰 越化学品有限公司)等试剂均以其元素天然化合物形式 存在,纯度高于99.95%;铝箔(厚度约为13 μm);铍 箔(厚度约为20 μm);异丙醇(分析纯)(天津市富宇精 细化工有限公司);异丁醇(分析纯); HNO₃(分析纯)

作者简介: 张鑫(1989--), 男, 甘肃兰州人, 硕士研究生, 从事核化学与放射化学研究

收稿日期: 2014-09-23; 修改日期: 2014-11-25

基金项目: 国家自然科学基金资助项目(20901080, 11079006, 11205216)

通信作者:秦芝,E-mail: qinzhi@impcas.ac.cn。

(白银试剂厂); 丙酮; NaOH 溶液; 去离子水。

2.2 实验装置

实验装置如图1所示,槽体由Pyrex玻璃材料制成, 呈圆锥形,底部内径14 mm,高115 mm,外加冷却循 环水套用于冷却电沉积液。沉积槽体与不锈钢底座间用 橡皮筋连接,并由垫于两者之间的橡皮"O"圈进行密 封,橡皮"O"圈密封垫的内径为12 mm,它决定了靶 膜的面积。分子镀过程以铂金丝为阳极,沉积槽体与不 锈钢底座之间的铝箔衬底作为阴极。另外,为更好地搅 拌电沉积液,将铂金丝阳极弯制成螺旋状固定于电极搅 拌器上。



图 1 (在线彩图)分子镀制靶实验装置图

2.3 原始溶液的配制

由文献[8]可知,分子镀法制备镧系靶时,电沉积 效率一般在85%以上,部分可达到98%。本研究中在 原始溶液用量70 µL条件下,根据所需靶的厚度,假 定90%的电沉积效率,初步确定原始溶液的浓度及试 剂的用量。现仅以元素Tb为例,说明原始溶液的配 置过程。称取0.5279gTb₄O₇固体,将其用5mL浓 度为16 mol/L的HNO₃在电炉加热的情况下溶解,然 后小心加热蒸干。再将蒸干后的固体与25.5mL浓度 为0.1 mol/L HNO₃混合,静置48h后固体完全溶解, 此时Tb^{x+}(x = 3, 4)的质量浓度为18.1596 mg/mL。 此溶液即可做为原始溶液使用。

2.4 实验流程

2.4.1 标准曲线的制作(以元素Tb为例)

在10 mL容量瓶中依次加入不同体积的浓度 为54.0816 µg/mL的Tb(NO₃)_x标准液、1000 µL异丙 醇、250 µL 0.1 mol/L的HNO₃,100 µL 0.2%偶氮胂 Ⅲ溶液,混合均匀后,在紫外可见分光光度计上以654 nm 波长分别快速地测定吸光度,作出吸光度-体积曲 线,并得出标准曲线方程。

2.4.2 镧系元素靶的制备

(1) 靶衬的预处理:实验中所用的铝箔靶衬需无针 孔。先用丙酮擦去铝箔表面的有机物质,再用一定浓度 的 NaOH 溶液除去铝箔表面的氧化膜,接着用去离子水 擦去铝箔表面多余的 NaOH 溶液,最后用异丙醇擦拭铝 箔表面,处理好后的靶衬备用。

(2) 靶子的镀制: 实验前用丙酮清洗镀槽各部件并 按照图1进行组装。组装后用少量异丙醇检查整个装置 的密封性,确保无液体漏出。然后用移液器移取70 μL 单一金属元素原始溶液与17 mL 异丙醇至分子镀槽中, 并加入适量的0.1 mol/L 的HNO₃,开启搅拌装置与冷 却水,搅拌均匀后,调节电流到一定值,反应1h后结 束电镀。将镀后液倒入预先准备好的试管中,用少量异 丙醇冲洗分子镀槽及靶膜,最后拆除装置,取出靶膜。

2.4.3 分子镀效率的确定

用移液器移取 200 μL镀后液于 10 mL 容量瓶中, 加入 800 μL异丙醇, 250 μL 0.1 mol/L HNO₃, 100 μL 偶氮胂III, 定容后测其吸光度^[6]。所得吸光度数值带入 该元素的标准曲线,经过简单计算可得分子镀效率。

3 结果和讨论

两极间距离、电流密度、氢离子浓度以及电沉积时 间等都是影响分子镀效率和镀层质量的重要因素,为了 得到适合进行重离子核反应的高质量核靶,需要确定最 佳条件。因研究中制备核靶较多,且工艺流程相近,现仅 以Tb靶的分子镀为例,说明核靶的制备过程。

3.1 两极间距离对电沉积效率的影响

为了选择合适的两极间距离,按照2.4中的实验方法,固定电流密度为5.3 mA/cm²,分子镀电沉积时间为1 h,0.1 mol/L HNO₃加入量为400 μL,调节阳极铂金丝的位置,考察阴阳极间距离对电沉积效率的影响,结果如图2所示。可以看出,两极间距离保持在10



~30 mm 之间均可得到较高的电沉积效率,但考虑到 镀槽形状以及实验中所用的镀液量,阳极距离阴极15 mm 更有利于反应液体的搅拌,所以选择两极间距离 为15 mm。

3.2 电流密度对电沉积效率的影响

按照2.4中的实验方法,控制两极间距离为15 mm、电沉积时间为1 h,0.1 mol/L HNO₃ 400 μL,通过改变电压,考察不同电流密度条件下 Tb 的电沉积效率,结果如图3所示。由图3可看出,分子镀效率随电流密度的增加而增大。当电流密度为5.3 mA/cm²时,电沉积1 h效率可达80%,从曲线的趋势可以看出,随着电流密度的增大,沉积效率还可以进一步提高,但是电流密度对电结晶质量的影响存在上下限。在电流密度下限值以下,提高电流密度有利于晶体生长,导致结晶粗化。在下限值以上,随着电流密度的提高,阴极极化和过电位增大,有利于晶核形成,结晶细化。为了得到较好的靶面结构,制备 Tb 靶时,选择电流密度为5.3 mA/cm²为宜。

实验也研究了在异丁醇-硝酸体系中,电流密度对 电沉积效率的影响,从实验数据看来,在电沉积时间 为4h、0.1 mol/L HNO₃加入量为200 μL、极间距为15 mm时,电流密度对电沉积效率影响不是很大,此时电 沉积效率都在94%以上,靶厚可达到1200 μg/cm²。国 外也有学者研究过在异丁醇-硝酸体系中制备锕系元素 靶的工艺,以²⁴⁴Pu为例,他们的分子镀时间为6h, 电流密度为1.4 mA/cm²,效率从60%~90%不等,靶 厚在 400~ 800 μg/cm之间。



图 3 电流密度对Tb电沉积效率的影响

3.3 酸的加入量对电沉积的影响

从实验的过程来看,加入酸的量对电沉积有两方面

的影响,一是电沉积的效率,二是靶膜的表面结构。

3.3.1 对电沉积效率的影响

按照 2.4 中的实验方法,固定极间距为 15 mm,分 子沉积时间为 1 h,电流密度为 2.7 mA/cm²,分别加 入 0.1 mol/L HNO₃ 50,100,150,200,250,300,350, 400 μL,以考察对 Tb 电沉积效率的影响。结果如图 4 所示。由图 4 可以看出,随着 HNO₃ 加入量的增大,电 沉积效率呈下降趋势。但是实验中仍选择加入 400 μL HNO₃,这是由于高浓度的氢离子可以保证很好的靶面 形态。



图 4 加入HNO₃的量对Tb电沉积效率的影响

3.3.2 对靶膜表面形态的影响

按照2.4 中的实验方法,固定极间距为15 mm, 分子沉积时间为1 h, 电流密度为2.7 mA/cm², 分别加入0.1 mol/L的HNO3 50 µL[图5(a)] 和400 μL [图 5(b)], 以考察对不同量的酸对Tb靶膜表面形态 的影响。对比图5(a)和(b)可以看出,在200倍的放 大倍数下,两种靶膜表面裂痕均较多,但图5(a)中的 靶膜裂块大小分布更为均匀;在500倍的放大倍数下, 图 5(a) 中的靶膜表面平滑、细腻,图 5(b) 中的靶膜表 面相对粗糙;在1000倍的放大倍数下,可以明显地看 出,两种靶膜表面均无更细小的裂痕,图5(b)中的靶膜 表面呈明显的颗粒状结晶,这是由于溶液中氢离子浓度 较高时,金属离子析出超电势增大,有利于使析出金属 粒径减小,而图5(a)中的靶膜表面下生长出晶须,正是 由于这种晶须的存在, 道中靶膜与靶衬之间的粘附力降 低,造成了靶膜疏松、易脱落等情况。根据以上分析, 虽然较小体积的酸可以提高沉积效率,但是,要以破坏 良好的靶膜表面为代价。疏松、易脱落的靶膜是不符合 相关实验要求的,所以在镀制过程中,应选择加入400 μL 0.1mol/L的HNO3进行沉积。



图 5 加入50 µL(a)和400 µL(b)0.1 mol/L HNO3的Tb靶SEM图

3.4 时间对电沉积效率的影响

按照2.4节的方法,控制两极间距离为15 mm,电 流密度为5.7 mA/cm²,0.1 mol/L HNO₃ 400 μL,通 过测量不同沉积时间镀后液中Tb的浓度,确定电沉积 效率的变化,结果如图6所示。从图中可以看出,Tb的 电沉积效率随时间延长呈上升趋势,在电沉积过程的 初始30 min 内,效率随时间线性增加,50 min 时已达 到85%,而后随着时间的延长,电沉积效率趋于稳定。 由此可见,1 h即可完成Tb的电沉积过程。



图 6 沉积时间对Tb电沉积效率的影响(异丙醇硝酸体系)

实验中也研究了在异丁醇-硝酸体系中,时间对电 沉积效率的影响,如图7所示。从图中可以看出,在相 同条件下,在异丁醇-硝酸体系中,沉积效率随时间的 变化是比较缓慢的,且达到沉积平衡需要更长的时间, 当沉积时间为3h时,沉积效率为92%;沉积时间为4 h时,效率可达99%以上。但是在异丁醇-硝酸体系中制 备的靶子,其靶膜比在异丙醇-硝酸体系中制备的靶子 靶膜更加致密,粘附性更好,表面分布更均匀。



图 7 沉积时间对Tb电沉积效率的影响(异丁醇-硝酸体系)

3.5 其他镧系靶的制备

以上以Tb为例说明了分子镀制备镧系靶的具体 过程和条件,由于Tb,Dy和Ho是镧系中三个相邻元 素,化学性质比较相似,因此Dy和Ho靶制作工艺和 流程与Tb靶的相同,均考察了极间距、电流密度、加 入HNO3的量和电沉积时间对分子镀的影响,确定了最 佳工艺条件。本文实验中采用13 µm的铝箔做为靶衬, 但是由于铝在重离子束轰击下可能产生干扰目标元素测 定的转移产物,因此常用铍箔代替铝箔作为靶衬材料, 本工作中也研究了部分靶在铍箔上的制备。

实验条件及靶厚数据见表1。

-111 -				
元素	靶衬/厚度 /μm	电流密度 /(mA/cm ²)	分子镀时间 /min	靶厚 /(µg/cm ²)
$^{\mathrm{Tb}}$	Al/13	5.7	60	1 100
$^{\mathrm{Tb}}$	$\mathrm{Be}/20$	0.8	60	570
Dy	Al/13	5.7	60	1100
Dy	$\mathrm{Be}/20$	0.8	60	580
Ho	Al/13	5.7	60	1200
Но	$\mathrm{Be}/20$	0.8	60	520

表 1 电沉积制备部分镧系靶的最佳实验条件及靶厚数据

对比表1中各实验条件可以看出,对于不同材料的 靶衬,所选用的电流密度是不一样的,在铍衬上镀靶的 电流密度比在铝衬上小很多,导致靶厚也比在铝衬上的 小很多。这是由于在选择条件时,发现在相同电流密度 下制备靶子时,铍箔表面会出现大量气泡,且持续时间 很长,但是铝箔没有这种现象出现。为了保护铍箔表面 不被腐蚀,从而选择了较低的电流密度。

4 靶的表面形貌分析

为了更好地观察靶的微观结构,用扫描电子显微 镜(SEM)分别对Tb靶、Dy靶、Ho靶进行了表面形 貌表征^[9]。三种元素的靶均是在相同沉积条件下镀 制的。图8(a),(b),(c)分别为不同放大倍数下Tb靶、 Dy 靶、Ho 靶的 SEM 照片。从图中可以看出,虽然 Tb, Dy 和 Ho 是三个相邻的镧系元素,但是它们各自靶膜的 微观表面形态差异很大。对比图 8(a), (b), (c), 在 200 倍的放大倍数下,三种元素的靶膜表面均有裂痕,这 是在靶干燥过程中,镀层表面张力所致^[10],但是它们 龟裂的程度不同。Tb和Ho的靶膜表面裂痕相对较少; Dv 靶表面裂痕密度很大,导致裂块体积很小; Ho 靶 表面有少部分尺度比较大的裂痕,其他均为细小裂 痕,看上去比其他两种元素的靶膜更具整体感。在500 倍的放大倍数下, Tb和Dv 靶膜裂痕无其他更小的结 构,而Ho靶膜显示出更为细小的裂痕,产生分形结构。 在1000倍的放大倍数下,可以看出,Tb靶膜表面很粗



图 8 Tb(a)、Dy(b)和Ho(c)靶SEM分析

糙,呈现出明显的颗粒状结晶; Dy和Ho靶膜相对光 滑、细腻,但Ho靶膜表面还有更为精细的结构,裂块 体积分布不均匀。

5 靶膜的化学成分分析

5.1 利用能谱仪对靶膜化学成分进行分析^[11]

Tb, Dy和Ho靶在铝衬上的能谱仪 (EDS) 谱图分 别如图9(a), (b)和(c)所示。三种元素的X射线峰都 很显著,然而由于仪器对氧元素不灵敏,图中缺少了氧 的X射线峰。图中之所以出现Al的X射线峰,是由于 制备的靶子干燥后,由于表面张力的作用,靶膜开裂, 使得铝箔裸露,从而在测定时出现了Al的X射线峰。 另外,由于铝箔中含有少量的杂质镁,因此在谱图中可 观测到微弱的镁的X射线峰。从以上分析和实验数据可 以得出,制备的靶子纯度很高,符合相关实验要求。



图 9 铝衬上Tb(a), Dy(b)和Ho(c)靶的EDS谱图

5.2 利用红外光谱对靶膜成分进行分析

 Tb₄O₇(纯度 99.99%) 红外谱图和Tb 靶膜红外谱
 图分别如图10(c) 和10(d)

 图分别如图10(a), 10(b) 所示。对比两张谱图可以看
 出,Ho靶膜红外谱图中出

 出,Tb靶膜红外谱图中出现了Tb₄O₇(纯度 99.99%)的
 两个特征峰,分别是3435.2 和1631.3,这证明Tb 靶

 放个特征峰,分别是3435.2 和1631.3,这证明Tb 靶
 膜中有Ho₂O₃存在。又可

 http://www.npr.ac.cn

膜中有Tb₄O₇存在。又可以从图10(b)看出,谱图中存 在1515.3,1393.8和847.0这三个峰,它们是NO₃的特 征峰^[12],从而可以证明Tb靶膜中存在Tb的硝酸盐, 这是由于进行分子镀时,所使用的主盐是Tb的硝酸盐 所致。



Ho₂O₃(纯度 99.99%) 红外谱图和Ho 靶膜红外谱 图分别如图10(c) 和10(d) 所示。对比两张谱图可以看 出,Ho靶膜红外谱图中出现了Ho₂O₃(纯度 99.99%) 的 两个特征峰,分别是3433.5和1632.3,这证明Ho 靶 膜中有Ho₂O₃存在。又可以从图10(d) 看出,谱图中存 DDT。AC,CD 在1519.7,1399.4和846.3 这三个峰,它们是NO₃的特征峰^[12],从而可以证明Ho靶膜中存在Ho的硝酸盐,这是由于进行分子镀时,所使用的主盐是Ho的硝酸盐 所致。

6 结果与讨论

(1) 比较系统地研究了以13 μm 厚的铝箔为阴极 材料制备部分镧系元素靶的实验条件,确定了最佳 的实验条件:极间距控制在15 mm,电流密度为5.7 mA/cm²,电压控制在300到450 V之间,电沉积时间 定为1 h, 0.1 mol/L HNO₃加入量为400 μL,原始溶 液加入量70 μL,异丙醇加入量17 mL。

(2)采用紫外可见分光光度法测量了分子镀沉积效率,避免了靶层上物质形态不明所带来的测量困难。

(3) 采用扫描电子显微镜 (SEM) 对靶子表面形态进 行了详细的分析,观察了微观状态下的靶子表面,得到 了在加入400 μL 0.1 mol/L HNO₃时可以获得较好靶 面形态的结论;采用EDS 对靶子和化学成分进行了定 性和半定量分析,从实验数据可以看出,靶子的纯度很 高,符合实验要求;采用红外光谱法对靶子成分结构进 行了分析,可以看出靶子成分结构较为复杂,不是单纯 的氧化物或其他单质,而是混合物。

(4) 目前,制得的 Tb 靶和 Ho 已用于中国科学院 近代物理研究所加速器 SFC低 能核化学终端上^[13] (如图 11 所示)。Tb 靶和 Ho 靶分别在¹⁹F 束流(流强 为 300 ~ 400 nA)下轰击了约 20 h^[13],靶面结构完好, 无破损、脱落等情况发生(如图 12 所示),完全符合本 次实验要求。



图 11 (在线彩图)中国科学院近代物理研究所加速器 SFC 低能核化学终端靶室示意图



图 12 (在线彩图)¹⁹F束流(流强为300 ~ 400 nA)轰击过的 Tb 靶(轰击时间20 h)(放射性)

参考文献:

- PERSHINA V. In the Chemistry of Superheavy Elements[M]. Schädel M. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2003: 31.
- [2] SCHÄDEL M. Angewandte C international edition, 2006, 45(3): 368.
- [3] LUO Xinhua, XU Guoji. Atomic Energy Science and Technology. 1989, 23(1): 82. (in Chinese)
 (罗兴华, 许国基. 原子能科学技术, 1989, 23(1): 82.)
- [4] ZHANG Lina, QIN Zhi, WU Xiaolei, et al. Nuclear Physics Review, 2008, 25(1): 56. (in Chinese)
 (张丽娜, 秦芝, 吴晓蕾, 等. 原子核物理评论, 2008, 25(1): 56.)
- [5] QIN Z, GUO J S, GAN Z G. plied Radiation and Isotopes, 2001, 54(5): 741.
- [6] LIU Yupeng. Chinese Journal of Analysis Laboratory, 2005, 21(3): 89. (in Chinese)

(刘宇鹏. 分析试验室, 2005, **21**(3): 89.)

- [7] EBERHARDT K, SCHÄDEL M, SCHIMPF E, et al. Nucl Instr Meth A, 2004, 521(1): 208.
- [8] EBERHARDT K, BRÜCHLE W, DÜLLMANN C E, et al. Nucl Instr Meth A, 2008, 590(1): 134.
- BAI Jing, WU Xiaolei, LIN Maosheng, et al. Nuclear Physics Review, 2010, 27(2): 187. (in Chinese)
- (白静, 吴晓蕾, 林茂盛, 等. 原子核物理评论, 2010, 27(2): 187.)[10] YANG Chunli, SU Shuxin, ZHANG Shengdong. ournal of
- [10] TARG Chull, 50 Shuxin, 2017, 29(4): 201. (in Chinese) (杨春莉, 苏树新, 张生栋. 核化学与放射化学, 2007, 29(4): 210.)
- [11] LIEBE D, EBERHARDT K, HARTMANN W, et al. Nucl Instr Meth A, 2008, 590(1): 145.
- [12] SPEIGHT J G. Lange's handbook of chemistry[M]. New York: McGraw—Hill, 2005: 425.
- [13] WANG Y, QIN Z, FAN F L, et al. Radiochimica Acta, 2014, 102(1-2): 69.

Preparation of Three Lanthanide Element Targets by Electrodeposition

ZHANG Xin^{1,2}, WU Xiaolei¹, CAO Shiwei^{1,2}, WANG Yang^{1,2,3}, QIN Zhi¹

(1. Institute of Modern Physics, Chinese Academy of Sciences, Lanzhou 730000, China;
2. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China;
3. Lanzhou University, Lanzhou 730000, China)

Abstract: Preparation of Tb, Dy and Ho targets from the mixture of isopropanol and nitricacid solution are studied by using molecular plating technique. To determine the optimum conditions for the deposition process, the effect of distance between the two electrodes, current density, volume of 0.1 mol/L nitric acid, deposition time on the quality and electrodeposition yield of the target films are investigated individually. Preparation of Tb targets from the mixture of isobutylalcohol and nitricacid solution are also studied by using molecular plating technique. Depending on the similar chemical properties of Tb, Dy and Ho, the same process conditions are used. The suitable distance between the two electrodes is 15 mm. The current density is $5.7 \text{ mA}/\text{ cm}^2$. The volume of nitric acid (0.1 mol/L) is 400 μ L. With the spectrophotometry method, the electrodeposition yields for all the targets prepared are found to be higher than 85% after one hour's deposition. The morphological structure of some targets are characterized by scanning electron microscope (SEM) and it can be seen that the surface of the targets are uniform and intact. With EDS method, the composition of some targets are found to be very pure. The chemical structure of the targets are analyzed by Infrared Spectroscopy. It is found that the chemical structure of the targets are complex and the target membrane is not composed by only one compound. Short lived isotopes of W and Os were produced from natural Tb and Ho targets bombarded by ¹⁹F beam at the SFC low energy radiochemical terminal of Institute of Modern Physics, Chinese Academy of Sciences, respectively, and were successfully applied in the model experiment of Sg (Z = 106) and Hs (Z = 108). Key words: molecular plating; lanthanide element target; deposition yield

Received date: 23 Sep. 2014; Revised date: 25 Nov. 2014 Foundation item: National Natural Science Foundation of China (20901080, 11079006, 11205216) Corresponding author: QIN Zhi, E-mail: qinzhi@impcas.ac.cn. http://WWW.npr.ac.cn